








	<h2 style="color: red;">FQU13N10LTU</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQU13N10LTU</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 10A IPAK</p> <p>Datenblätter:  FQU13N10LTU.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3073 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQU13N10LTU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 10A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3073 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	5 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 10A (Tc) 2.5W (Ta), 40W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	I-PAK
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 40W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	180 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	520pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQU13N10LTU ist neu im Original, Suche FQU13N10LTU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQU13N10LTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQU13N10LTU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQU13N10L @@@@ FAIRC FQU13N10L @@@@ FAIRC</p>	 <p>FQU13N10TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A IPAK</p>	 <p>FQU16N05 FAIRCHILD FAIRCHILD TO-251</p>	 <p>FQU13N06TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 10A IPAK</p>
 <p>FQU13N10 @@@@ FAIRC FQU13N10 @@@@ FAIRC</p>	 <p>FQU13N10TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A IPAK</p>	 <p>FQU15N06L F F TO-251</p>	 <p>FQU13N10 F FQU13N10 F</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQU10N20	↔ FQU10N20C	⇒ FQU10N20CTU	D FQU10N20CTU	↗ FQU10N20L
⊣ FQU11P06	⊗ FQU11P06TU	D FQU11P06TU	⇒ FQU12N20	↗ FQU12N20L
⊗ FQU12N20TU	⊣ FQU12N20TU	⊗ FQU13N06	↔ FQU13N06L	↗ FQU13N06LTU
D FQU13N06LTU	⊗ FQU13N10	⊣ FQU13N10L	⊗ FQU13N10LTU	↗ FQU17N08L
⇒ FQU17P06	↔ FQU17P06TU	⊗ FQU17P06TU	⊣ FQU1N50C	↗ FQU1N60B
↔ FQU1N60C	⇒ FQU1N60CTU	D FQU1N60CTU	⊗ FQU1N80TU	⊣ FQU1N80TU
⊗ FQU20N06	D FQU20N06L	⇒ FQU20N06LTU	↔ FQU20N06LTU	↗ FQU2N50B
⊣ FQU2N50BTU	⊗ FQU2N50BTU	↔ FQU2N60/SSU2N60	⇒ FQU2N60A	↗ FQU2N60B
⊗ FQU2N60C	⊣ FQU2N60CTU	⊗ FQU2N60CTU	D FQU2N65C	↗ FQU2N90TU
↔ FQU2N90TU	⊗ FQU30N06L	⊣ FQU3N40TU	⊗ FQU3N40TU	↗ FQU3N50C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited